

## 2SD1506

エピタキシャルプレーナ形 NPN シリコントランジスタ  
 低周波電力増幅用/Low Freq. Power Amp.  
 Epitaxial Planar NPN Silicon Transistor

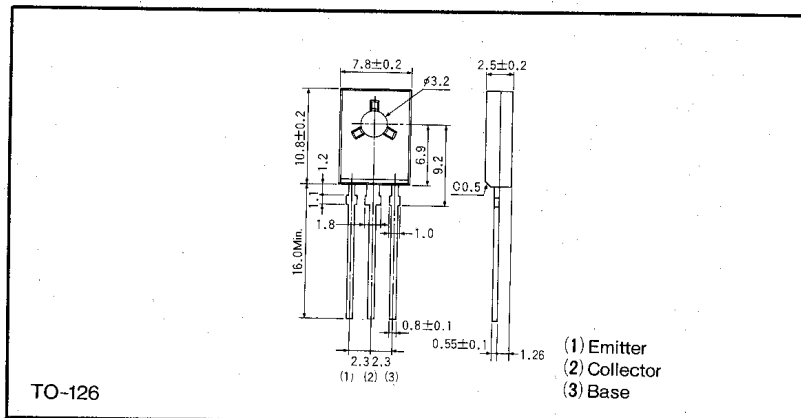
## ● 特長

- 1)  $V_{CE(sat)}=0.5V$  (Typ.) と低い。  
(at  $I_C/I_B=2A/0.2A$ )
- 2) ASOが広く破壊に強い。
- 3) 2SB1065とコンプリである。
- 4) 放熱器への取付けが容易にできる。

## ● Features

- 1) Low collector saturation voltage:  
 $V_{CE(sat)}=0.5V$  (Typ.)  $I_C/I_B=2A/0.2A$
- 2) ASO is wide and resistant to break-down.
- 3) Complementary pair with 2SB1065.
- 4) Easy installation into radiators.

## ● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)

トランジスタ  
2SDタイプ

## ● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	50	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	5	V
コレクタ電流	$I_C$	3	A
		4.5	A(Pulse)
コレクタ損失	$P_C$	10	W( $T_c=25^\circ C$ )
		1.2	W( $T_a=25^\circ C$ )
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存温度範囲	$T_{stg}$	-55~150	$^\circ C$

## ● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$BV_{CEO}$	50	—	—	V	$I_C=1mA$
コレクタ・ベース降伏電圧	$BV_{CBO}$	60	—	—	V	$I_C=50\mu A$
エミッタ・ベース降伏電圧	$BV_{EBO}$	5	—	—	V	$I_E=50\mu A$
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	—	—	1.0	$\mu A$	$V_{CB}=40V$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	—	—	1.0	$\mu A$	$V_{EB}=4V$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	1.0	V	$I_C/I_B=2A/0.2A$
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	—	—	1.5	V	$I_C/I_B=2A/0.2A$
直流電流増幅率	$h_{FE}$	56	—	390	—	$V_{CE}/I_C=3V/0.5A$
利得帯域幅積	$f_T$	—	90	—	MHz	$V_{CE}=5V, I_E=-0.5A$
出力容量	$C_{ob}$	—	40	—	pF	$V_{CB}=10V, I_E=0A, f=1MHz$

$h_{FE}$  の値により下表のように分類します。

Item	N	P	Q	R
$h_{FE}$	56~120	82~180	120~270	180~390

## ● 標準品・準標準品一覧表

Type	$h_{FE}$	包装名	バルク
		記号	
2SD1506	NPQR	基本発注単位(個)	1 000
			○

(◎:標準品 ○:準標準品)